

物理電子システム創造専攻 平成17年度 博士中間発表会プログラム

資料

2005年6月3日版

会場：G5-511

2005年6月16日

(旧物情：発表15分, 質疑25分 / 旧電シ：発表15分, 質疑5分)

開始時間	研究室		名前	題名
9:00	岩井・杉井研	D2後	ンジン アン	A Study on Mobility of High-k Gate Dielectric MISFET
9:20	岩井・杉井研	D2	モリナ レイエス ホエル	Study on the Reliability of Metal Gate / High-k Insulator Stack Structures for Transistors of Next Generation
9:40	有本・石原研	D2	田渕 良志明	Pt/(Bi, Nd) ₄ Ti ₃ O ₁₂ /HfO ₂ /Si(100)ゲート構造を用いたMFIS-FETの作製と特性向上に関する研究
10:00	宮本研	D2	松浦 哲也	MBE法によるGaAs上長波長帯GaInAsSb系量子ドットとレーザ応用
10:40				
10:50	徳光研	D2	斎木 博和	強誘電体ゲート型メモリ素子の集積化に関する研究
11:10	伊藤研(旧大津研)	D3	林 定植	ZnOナノ微結晶作成およびナノフォトニックデバイスへの応用に関する研究
11:30	伊藤研	D3	山田 俊吾	エバネッセント光ファネルにおけるSisyphus冷却と出力原子ビームの高フラックス化
11:50	伊藤研	D3	山本 和広	近接場光スリットを用いた冷却Rb原子の偏向
12:10				
13:10	益研	D2	伊藤 浩之	集積回路における高速信号配線技術の研究
13:30	岩井・筒井研	D2	佐々木雄一朗	プラズマドーピングに関する研究開発
13:50	筒井研	D2	渡邊 聡	弗化物共鳴トンネルダイオードを混載したシリコン集積回路に関する研究
14:10	渡辺研	D2	金澤 徹	弗化物系超ヘテロ結晶の創製とシリコン集積量子デバイス
14:50	渡辺研	D2	自念 圭輔	Si基板上弗化物系サブバンド間遷移レーザの研究
15:30	谷・半那研	D2	戸田 徹	液晶性有機半導体/電極界面の電気特性とその制御
16:10				
16:20	小林研	D2	来見田 淳也	全光信号処理ノードサブシステムに関する研究
17:00	小山研	D2後	ウィガネス	Study on High-Performance Integrated Vertical-Cavity Tunable Photonic Devices using MEMS Technology and Their Applications
17:40	青柳研	D2	布施 智子	カーボンナノチューブ量子ドットの電磁波応答